# U盘文件读写模块的并口连接说明

版本: 2D http://wch.cn

### 1、接口定义

模块具有两个外部接口: P1 是 USB 插座,可以直接插入 U 盘或者通过 USB 延长线连接 U 盘,当进行程序升级或者重新配置时应该通过 USB 对连线连接计算机的 USB 端口; P2 是 16 脚的双排针或者插座,用于连接单片机系统。

标准版模块可以由工具软件设置,使之工作于并口方式或者串口方式。

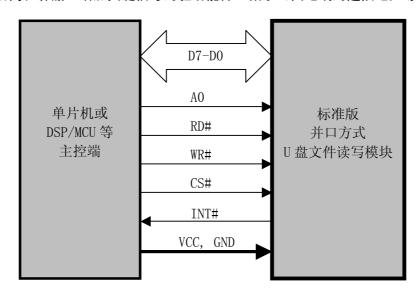
有关串口的引脚和协议说明,请参考 CH375HMS. PDF 文档。

在并口方式下,外部系统的单片机与模块的 P2 端口相连接。模块可以通过 8 位数据线 D0-D7、读 RD#、写 WR#、片选 CS#信号线直接挂在单片机的 8 位系统总线上,除此之外,模块的中断输出 INT#还应该连接到单片机的一个 I/0 引脚(查询方式)或者中断输入引脚(中断方式)。

模块的被动并口由双向缓冲接口芯片 CH421A 提供,单片机与模块之间的数据交换在 CH421A 芯片的 68 字节缓冲区中进行。当单片机系统向模块读写数据时,首先应该向模块的索引端口写入索引地址 0~67,然后读写数据端口,每次读写一个字节数据后,CH421A 自动将索引地址加 1,以便单片机直接读写下一地址的数据。详细的操作步骤及时序可以参考 CH421A 芯片手册中关于 X 端口的说明。

1)女法一门	远班的效加。	<b>计</b> 知时30米1F少	源及的方向次多名 OH+2 IA 心门 ) 加十久 ) 《페白的说初·		
引脚号	引脚名称	类型	并口方式下的 P2 端口引脚说明		
16	GND	电源	公共接地端		
15	VCC	电源	5V 正电源输入端,电源供给电流大于 100mA,		
			需要外接电源退耦电容,容量不小于 200uF		
14	CS#	输入	片选控制输入,低电平有效		
13	NC.	保留	保留引脚,禁止连接,禁止电平变化		
13	NO.	休田	(注:在旧版模块中是启动信号输入,下降沿有效)		
12	WR#	输入	写选通输入,低电平有效		
11	RD#	输入	读选通输入,低电平有效		
10	A0	输入	地址信号线,为0时指向索引口,为1时指向数据口		
9	INT#	输出	中断请求输出,低电平有效,带上拉开漏输出		
1~8	D0∼D7	双向三态	8 位双向数据总线,内置弱上拉电阻		

注: 并口连线较长时,需要特别考虑 CS#和 RD#以及 WR#等控制线的串扰问题,解决方法是对关键信号进行隔离和屏蔽、增加关键信号的驱动能力、减小公共地线的连接电阻等。

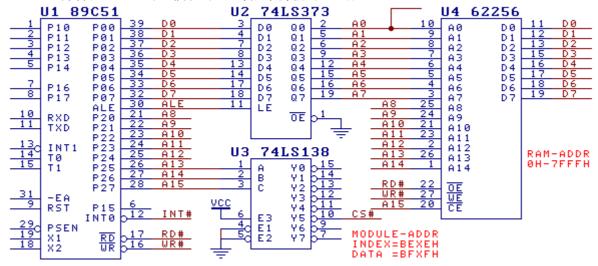


## 2、参考电路

以下参考电路都是以 MCS51 单片机为例,其它类型的单片机可以参考修改。

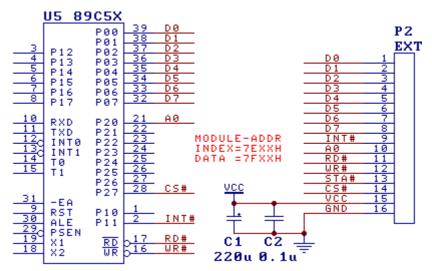
#### ① 并口连接,INT#中断通知

示例程序的应用环境就是采用这种连接方式,有关与模块连接的端口请参考连接电路图②中的 P2 端口。模块的 INT#连接到单片机的中断引脚 INTO (或者 INT1),如果使用查询方式,那么可以用普通 I/O 引脚代替 INTO 引脚。模块的 AO 可接单片机的 AO 或 A8。



#### ② 并口连接,INT#查询状态

图中的 P2 端口就是连接模块的端口。由于模块的 CS#连接到单片机的 A15 引脚,所以其端口地址范围为 0000H-7FFFH,如果需要连接外部 RAM,那么其地址应该在 8000H 以上才能避免冲突。如果不连接外部 RAM,例如采用具有 1KB 以上内部 RAM 的单片机,那么应该避免在读取内部 RAM 时与模块地址冲突。当然,最佳方法是参考连接电路图①由地址译码电路 U3 产生模块的 CS#信号。



### 3、接口操作

基本操作步骤是,单片机系统将命令码、后续参数长度(因为各命令码所需要的参数不等长)和 参数写给模块,并通知其启动操作,模块执行完成后以中断方式通知单片机,并返回操作状态和操作 结果。

因为接口操作看起来比较复杂,所以实际过程可以参考随模块一起提供的几个示例程序,直接用其中的 ExecCommand 子程序就可以了,不必理解下面的接口步骤说明。

该操作步骤适用于 V3.1 及以上版本的模块,与之前版本的模块的操作步骤不同。

并口方式的操作步骤是(请参考示例程序中的 ExecCommand 子程序):

- ① 基本概念:并口数据交换通过模块的 CH421A 芯片进行,外部单片机与模块交换数据实际上就是单片机存取 CH421A 芯片的内部缓冲区。当模块挂在外部单片机的系统总线上时,模块需要占用外部单片机系统的两个 I/0 地址,模块的 I/0 地址就是 CH421A 芯片的 I/0 地址,低地址为索引端口,高地址为数据端口。CH421A 芯片提供 66 字节的双口 SRAM 缓冲区(地址为 00H-41H)以及两个字节的单向缓冲区(地址为 42H 和 43H)。模块的通讯协议约定,从地址 PARA\_BUFFER\_ADDR 即 00H 开始的 64 个字节是数据块缓冲区,地址范围是 00H-3FH;地址 PARA\_COMMAND\_ADDR 即 40H 是操作命令码的单元地址,该单元由单片机在操作前设置,由模块在操作完成后清除;地址 PARA\_STATUS\_ADDR 即 41H 是操作结果状态码的单元地址,该单元由模块在操作完成后设置;地址 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 即 42H 是命令包长度的单元地址,该单元低 7 位为后续参数的长度,最高位用于通知模块,为 1 则激活/继续,为 0 则结束/应答,该单元由单片机在操作前设置;地址 PARA\_STS\_LEN\_ADDR 即 43H 是状态包长度的单元地址,该单元低 7 位为后续参数的长度,由模块在操作完成后设置以返回给单片机。
- ② 单片机系统将命令码写到 CH421A 的索引地址 PARA\_COMMAND\_ADDR 中,将命令的后续参数写到 CH421A 的索引地址 PARA\_BUFFER\_ADDR 开始的缓冲区中,并将这些后续参数的长度写到 CH421A 的索引地址 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 中并设置该单元最高位为 1 以激活操作,有些命令不需要任何参数,那么参数的长度就应该是 0(由于最高位为 1,实际数据是 80H)。
- ③ 默认情况下,PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 0,当单片机系统设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 1 后,该 0−1 转变将通知模块启动操作。
- ④ 模块检测到 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的 0-1 转变后,从 CH421A 读取命令码及可选的参数,然后分析命令码并执行。
- ⑤ 对于以字节为单位的文件数据块读写操作请跳过此步骤,对于以扇区为单位的文件数据块读写操作还应该有以下步骤,每读写一个扇区的数据,以下过程就会重复 8 次,每次传输 64 字节的数据,共 8 次可以传输一个扇区的数据。每次传输过程必须在 2mS 时间之内完成,否则有些 U 盘可能会工作不正常。
  - 如果是 CMD\_FileRead 或 CMD\_FileReadLast 命令,模块将请求读取数据的状态码 USB\_INT\_DISK\_READ 写到 CH421A 的索引地址 PARA\_STATUS\_ADDR,然后模块的 INT#引脚输出低电平。单片机系统检测到 INT#的低电平后,应该从 CH421A 的 PARA\_STATUS\_ADDR 读取状态码,接着设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 0(作为中断应答),然后从 CH421A 的索引地址 PARA\_BUFFER\_ADDR 开始,连续取走 64 字节的数据块,取走 64 字节数据后,单片机系统应该设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 1,通知模块已经取走数据,可以继续。
  - 如果是 CMD\_FileWrite 命令,模块将请求写入数据的状态码 USB\_INT\_DISK\_WRITE 写到 CH421A 的索引地址 PARA\_STATUS\_ADDR,然后模块的 INT#引脚输出低电平。单片机系统 检测到 INT#的低电平后,应该从 CH421A 的索引地址 PARA\_STATUS\_ADDR 读取状态码,接 着设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 0 (作为中断应答),然后从 CH421A 的索引地址 PARA\_BUFFER\_ADDR 开始,连续写入 64 字节的数据块,写完数据后,单片机系统应该设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 1,通知模块已经写入数据,可以继续。
  - 如果模块在数据读写过程中检测到错误,那么模块将读写数据块失败重试状态码USB\_INT\_DISK\_RETRY写到CH421A的索引地址PARA\_STATUS\_ADDR,然后模块的INT#引脚输出低电平。单片机系统检测到INT#的低电平后,应该从CH421A的索引地址PARA\_STATUS\_ADDR 读取状态码,接着设置PARA\_CMD\_LEN\_ADDR的最高位为0(作为中断应答),然后从CH421A的索引地址PARA\_BUFFER\_ADDR开始连续读取两个字节的数据,之后,单片机系统应该设置PARA\_CMD\_LEN\_ADDR的最高位为1,通知模块可以继续。读取的两个字节是一个16位的数据,指定需要回改指针的字节数,大端时高字节在前,小端时低字节在前。用户端程序接收到USB\_INT\_DISK\_RETRY状态码后,应该根据该16位数据回改文件数据缓冲区指针,以便重新发送或接收数据。
- ⑥ 模块执行完成,将操作状态码写到 CH421A 的索引地址 PARA STATUS ADDR。如果状态码为操

作成功 ERR\_SUCCESS,那么模块还将后续的结果数据的总长度写到 CH421A 的索引地址 PARA\_STS\_LEN\_ADDR 中,并从 CH421A 的索引地址 PARA\_BUFFER\_ADDR 开始写入结果数据。有些命令执行后没有结果数据返回,那么结果数据的长度就会是 0。

- ⑦ 模块将 PARA\_COMMAND\_ADDR 清零,并使 INT#引脚输出低电平,通知单片机系统该命令操作完成。
- ⑧ 单片机系统收到 INT#的低电平中断(或者下降沿中断,或者定期查询发现 INT#为低电平)后,从 CH421A 读取返回的状态码及可选的结果数据,然后设置 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位为 0 (作为中断应答)。当模块收到下一个启动操作信号(指 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 最高位的 0-1 转变)或者 PARA\_CMD\_LEN\_ADDR 的最高位恢复为 0 时,就会将模块的 INT#引脚恢复为高电平,撤消对单片机的中断请求。至此,一个操作完成。

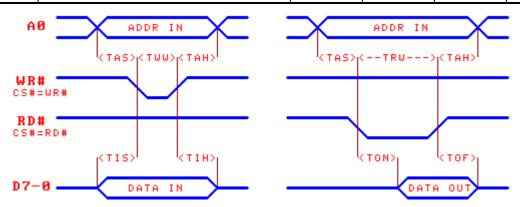
# 4、接口时序

测试条件: TA=25℃, VCC=5V

(RD 是指 RD#信号有效并且 CS#信号有效, RD#=CS#=0 执行读操作)

(WR 是指 WR#信号有效并且 CS#信号有效,WR#=CS#=0 执行写操作)

,					
名称	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位
TWW, TRW	读/写选通脉冲 RD/WR 的宽度	80			nS
TPC	并口读操作或者写操作的周期	100			nS
TAS	RD/WR 前的地址建立时间	10			nS
TAH	RD/WR 后的地址保持时间	6			nS
TIS	RD/WR 前的数据建立时间	3			nS
TIH	RD/WR 后的数据保持时间	5			nS
TON	读选通 RD 有效到数据输出有效	0	50	70	nS
TOF	读选通 RD 无效到数据输出无效	0		25	nS
TINT	收到撤消条件到 INT#恢复高电平			5	uS



# 5、注意事项

- ① 连线距离尽可能地简短;如果使用排线并且连线长度超过15cm,建议每两根信号线之间加一根接地线做间隔,即一根信号线配一根地线,防止数字信号串扰;如果连线长度超过30cm,那么必须加入与信号线数量相等的间隔地线;尤其是控制信号线,例如CS#、RD#、WR#,在较远距离连接时,特别要注意防止相互之间的干扰和数据线对它们的干扰。
- ② 如果连线有一定长度,并且外部单片机系统为准双向 I/O 端口,例如 MCS51,那么建议在相应的 I/O 引脚加上拉电阻(阻值为几 KΩ,高速时可再小些),提升高电平驱动能力。
- ③ 并口连线中的 GND 地线必须连接可靠,否则在操作耗电较大的 U 盘时会影响并口数据传输。